

882M

硅 NPN 外延平面晶体管芯片(4 ")

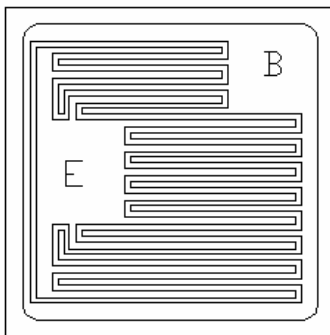
■ ■ 用途:

- *中等功率放大器
- *中速开关应用

■ 特征:

- *集电极电流: 3A
- *有效图形数: 6184

■ 芯片示意图



■ 芯片结构

芯片尺寸	1080 μ m × 1080 μ m
压焊区尺寸	基 区 290 μ m × 290 μ m 发射区 290 μ m × 340 μ m
芯片厚度	225 ± 10 μ m
锯片槽宽度	40 μ m
金属层	正面: Al 3.1 ± 0.2 μ m 背面: Ag 1.4 ± 0.2 μ m

■ 电特性(Ta=25℃)

参数名称	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	BV _{CBO}	I _C = 0.1 mA, I _E = 0	40		V
集电极-发射极击穿电压	BV _{CEO}	I _C =1 mA, I _B = 0	30		V
发射极-基极击穿电压	BV _{EBO}	I _B =0.1 mA, I _C = 0	6		V
集电极-基极截止电流	I _{CBO}	V _{CB} = 0.8BV _{CBO} , I _E = 0		0.5	μ A
发射极-基极截止电流	I _{EBO}	V _{EB} = 4V, I _C = 0		0.5	μ A
直流电流增益	h _{FE}	V _{CE} =2V, I _C = 1A	100	400	
集电极-发射极饱和电压	V _{CES}	I _C = 2A, I _B =0.2A		0.5	V
基极-发射极饱和电压	V _{BES}	I _C = 2A, I _B =0.2A		1.2	V